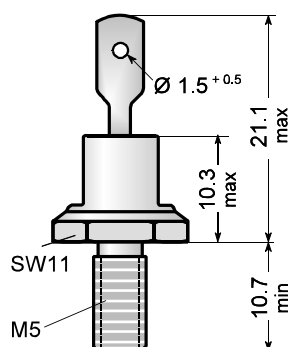


Silicon-Power Rectifiers

Silizium-Leistungs-Gleichrichter



Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	12 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Metal case – Metallgehäuse	DO-4
Weight approx. – Gewicht ca.	5.5 g
Recommended mounting torque Empfohlenes Anzugsdrehmoment	18 ± 10% lb.in. 2 ± 10% Nm
Standard: Cathode to stud / am Gewinde	
Index R: Anode to stud / am Gewinde (e.g. 1N 1199 A/R)	

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
1N 1199 A = PBY 271	50	60
1N 1200 A = PBY 272	100	120
1N 1202 A = PBY 273	200	240
1N 1204 A = PBY 274	400	480
1N 1206 A = PBY 275	600	720
1N 3671 = PBY 276	800	1000
1N 3673 = PBY 277	1000	1200

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	12 A ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	40 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	220 A
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	240 A
Rating for fusing – Grenzlasterintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	240 A ² s

¹⁾ Valid, if the temp. of the stud is kept to 100°C – Gültig, wenn die Temp. am Gewinde auf 100°C gehalten wird
26.03.2002

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 65...+175°C
 T_s – 65...+175°C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 30\text{ A}$	V_F	< 1.5 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 100 μA
Thermal resistance junction to stud Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	< 2 K/W

